

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Мармалюк Александр Анатольевич
2	Дата рождения (полная)	27 марта 1970 г.
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	доктор технических наук (специальность – 05.27.06 – Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники)
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 3, корп. 1, https://www.polyus.info , bereg@niipolyus.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полус» имени М.Ф. Стельмаха»
	Ведомственная принадлежность организации	ГК «Ростех»
	Тип организации	Акционерное общество
	Наименование подразделения	Научно-технический центр
	Должность	Начальник НТЦ
7	<p align="center">Основные публикации в области диссертационного исследования</p> <p>(для членов, представляющих технические науки: не менее 7 научных статей за последние 5 лет в изданиях из перечня ВАК, из которых не менее 2-х в Scopus/WoS; для членов, представляющих физико-математические науки: не менее 8 научных статей за последние 5 лет в изданиях из перечня ВАК, из которых не менее 3-х в Scopus/WoS; для членов, представляющих экономические науки: не менее 6 научных статей за последние 5 лет в изданиях из перечня ВАК, из которых не менее 1 в WoS/Scopus, а также не менее 1 рецензируемой монографии):</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Н. А. Волков, К. Ю. Телегин, Н. В. Гультиков, Д. Р. Сабитов, А. Ю. Андреев, И. В. Яроцкая, А. А. Падалица, М. А. Ладугин, А. А. Мармалюк, Л. И. Шестак, А. А. Козырев, В. А. Панарин. Улучшение параметров вольт-амперной характеристики полупроводниковых лазеров InGaAs/AlGaAs/GaAs ($\lambda = 940-980$ нм) с расширенным асимметричным волноводом // Квантовая электроника, 52:2 (2022), 179–181 2. E. Cherotchenko, V. Dudelev, D. Mikhailov, G. Savchenko, D. Chistyakov, S. Losev, A. Babichev, A. Gladyshev, I. Novikov, A. Lutetskiy, D. Veselov, S. Slipchenko, D. Denisov, A. Andreev, I. Yarotskaya, K. Podgaetskiy, M. Ladugin, A. Marmalyuk, N. Pikhtin, L. Karachinsky, V. Kuchinskii, A. Egorov and G. Sokolovskii. «High-Power Quantum Cascade Lasers Emitting at 8 μm: Technology and Analysis». Nanomaterials. -2022. - Vol. 12. - N. - 22. - pp. 3971. 3. Бабичев А.В., Гладышев А.Г., Денисов Д.В., Дюделев В.В., Михайлов Д.А., Слипченко С.О., Лютецкий А.В., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., Андреев А.Ю., Яроцкая И.В., Подгаецкий К.А., Мармалюк А.А., Падалица А.А., Ладугин М.А., Цихтин Н.А., Соколовский Г.С., Егоров А.Ю. Гетероструктуры квантово-каскадных лазеров с неселективным заращиванием методом газофазной эпитаксии // Письма в ЖТФ. 2021. Т. 55. №24. С. 1229-1235. 	

4. S.O. Slipchenko, A.A. Podoskin, O.S. Soboleva, V.S. Golovin, D.N. Romanovich, V.A. Kapitonov, A.S. Kazakova, K.V. Bakhvalov, N.A. Pikhtin, T.A. Bagaev, M.A. Ladugin, A.A. Padalitsa, **A.A. Marmalyuk**, V.A. Simakov Low-Voltage Thyristor Heterostructure for High-Current Pulse Generation at High Repetition Rate // IEEE Transactions on Electron Devices. 68 (6) (2021), 2855-2860
5. Ю. К. Бобрецова, Д. А. Веселов, А. А. Подоскин, Н. В. Воронкова, С. О. Слипченко, М. А. Ладугин, Т. А. Багаев, **А. А. Мармалюк**, Н. А. Пихтин. Экспериментальная методика исследования оптического поглощения в волноводных слоях полупроводниковых лазерных гетероструктур // Квантовая электроника, 51:2 (2021), 124–128
6. Н. А. Волков, Т. А. Багаев, Д. Р. Сабитов, А. Ю. Андреев, И. В. Яроцкая, А. А. Падалица, М. А. Ладугин, **А. А. Мармалюк**, К. В. Бахвалов, Д. А. Веселов, А. В. Лютецкий, Н. А. Рудова, В. А. Стрелец, С. О. Слипченко, Н. А. Пихтин, “Полупроводниковые лазеры InGaAs/AlGaAs/GaAs ($\lambda = 900\text{--}920$ нм) с расширенным асимметричным волноводом и улучшенной вольт-амперной характеристикой”, Квантовая электроника, 51:10 (2021), 905–908
7. Асланян А.Э., Авакянц Л.П., Червяков А.В., Туркин А.Н., Мирзай С.С., Курешов В.А., Сабитов Д.Р., **Мармалюк А.А.** Исследование напряженности внутренних электрических полей в активной области светодиодных структур на основе InGaN/GaN с разным числом квантовых ям методом спектроскопии электропропускания // Физика и техника полупроводников. 2020. Т. 54. No4. С. 420-425.
8. Асланян А.Э., Авакянц Л.П., Червяков А.В., Туркин А.Н., Курешов В.А., Сабитов Д.Р., **Мармалюк А.А.** Фотореверсивный ток в светодиодных гетероструктурах на основе InGaN/GaN с разным количеством квантовых ям // Физика и техника полупроводников. 2020. Т. 54. No3. С. 292-295.
9. S.O. Slipchenko, A.A. Podoskin, V.S. Golovin, P.S. Gavrina, V.V. Shamakhov, D.N. Nikolaev, V.V. Zolotarev, N.A. Pikhtin, T.A. Bagaev, M.A. Ladugin, **A.A. Marmalyuk**, V.A. Simakov Low-Voltage AlGaAs/GaAs Thyristors as High-Peak-Current Pulse Switches for High-Power Semiconductor Laser Pumping // IEEE Transactions on Electron Devices. 2020. V. 67 (1) P. 193-197
10. М.М. Зверев, Н.А. Гамов, Н.И. Гладышев, Е.В. Жданова, Д.Е. Локтионов, В.Б. Студенов, В.А. Курешов, А.В. Мазалов, Д.Р. Сабитов, А.А. Падалица, **А.А. Мармалюк**, В.И. Козловский, В.Б. Митюхляев Изменение свойств структур AlGaIn/InGaIn/GaN в процессе работы лазеров импульсно-периодического действия на их основе с электронной и оптической накачкой // Поверхность. 2019. No2. С. 37-41.
11. К. Ю. Телегин, М. А. Ладугин, А. Ю. Андреев, И. В. Яроцкая, Н. А. Волков, А. А. Падалица, А. В. Лобинцов, А. Н. Апарников, С. М. Сапожников, **А. А. Мармалюк**, “Влияние легирования волновода на выходные характеристики лазерных излучателей на основе AlGaAs/GaAs”, Квантовая электроника, **50**:5 (2020), 489–492

	<p>12. M.A. Ladugin, I.V. Yarotskaya, T.A. Bagaev, K.Yu. Telegin, A.Yu. Andreev, I.I. Zasavitskii, A.A. Padalitsa, A.A. Marmalyuk Advanced AlGaAs/GaAs Heterostructures Grown by MOVPE // Crystals. 2019, V. 9, P. 305</p> <p>13. М.А. Ладугин, А.Ю. Андреев, И.В. Яроцкая, Ю.Л. Рябоштан, Т.А. Багаев, А.А. Падалица, А.А. Мармалюк, М.Г. Васильев Сравнительный анализ квантовых ям GaAs/GaInP и GaAs/AlGaAs, полученных в условиях МОС-гидридной эпитаксии // Неорганические материалы. 2019. Т. 55. № 4. С. 345-349.</p>
8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты